

随意契約に係る情報の公開（委託研究）

< 随意契約一覧表（平成26年11月） >

契約の名称	契約者の氏名並びに所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした理由	契約金額（円）	再就職の役員の数
「コンクリート内部を可視化する後方散乱X線装置の開発」に関する委託事業	理事長 中鉢 良治（東京都千代田区霞が関一丁目3番1号）	平成26年11月1日	株式会社BEAMX 神奈川県横浜市常盤町一丁目2番地1 関内電子ビル10階	本事業は、独立行政法人科学技術振興機構からの委託事業「コンクリート内部を可視化する後方散乱X線装置の開発」であり、再委託先の研究課題及び研究機関が決定されているため。	25,000,000	-
「コンクリート内部を可視化する後方散乱X線装置の開発」に関する委託事業	理事長 中鉢 良治（東京都千代田区霞が関一丁目3番1号）	平成26年11月1日	国立大学法人名古屋大学 愛知県名古屋市千種区不老町	本事業は、独立行政法人科学技術振興機構からの委託事業「コンクリート内部を可視化する後方散乱X線装置の開発」であり、再委託先の研究課題及び研究機関が決定されているため。	10,000,000	-
「次世代SiCウエハの技術開発」のうち、「溶液法によるSiC結晶欠陥制御/成長安定化技術の原理実証」に関する委託事業	理事長 中鉢 良治（東京都千代田区霞が関一丁目3番1号）	平成26年11月11日	国立大学法人名古屋大学 愛知県名古屋市千種区不老町	本事業は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構からの委託事業「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）/次世代パワーエレクトロニクス/SiCに関する拠点型共通基盤技術開発/SiC次世代パワーエレクトロニクスの統合的研究開発」であり、再委託先の研究課題及び研究機関が決定されているため。	10,000,000	-
「次世代SiCウエハの技術開発」のうち、「キャリア寿命の深さ分布計測技術」に関する委託事業	理事長 中鉢 良治（東京都千代田区霞が関一丁目3番1号）	平成26年11月11日	国立大学法人名古屋工業大学 愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番	本事業は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構からの委託事業「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）/次世代パワーエレクトロニクス/SiCに関する拠点型共通基盤技術開発/SiC次世代パワーエレクトロニクスの統合的研究開発」であり、再委託先の研究課題及び研究機関が決定されているため。	12,000,000	-
「次世代SiCウエハの技術開発」のうち、「SiCにおける伝導度発現機構解明」に関する委託事業	理事長 中鉢 良治（東京都千代田区霞が関一丁目3番1号）	平成26年11月11日	学校法人大阪電気通信大学 大阪府寝屋川市初町18番8号	本事業は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構からの委託事業「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）/次世代パワーエレクトロニクス/SiCに関する拠点型共通基盤技術開発/SiC次世代パワーエレクトロニクスの統合的研究開発」であり、再委託先の研究課題及び研究機関が決定されているため。	18,000,000	-

随意契約に係る情報の公開（委託研究）

< 随意契約一覧表（平成26年11月） >

契約の名称	契約者の氏名並びに所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした理由	契約金額（円）	再就職の役員の数
「次世代SiCデバイスの技術開発」のうち、「SiC新酸化膜界面形成法原理実証」に関する委託事業	理事長 中鉢 良治（東京都千代田区霞が関一丁目3番1号）	平成26年11月11日	国立大学法人大阪大学 大阪府吹田市山田丘2番1号	本事業は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構からの委託事業「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）/次世代パワーエレクトロニクス/SiCに関する拠点型共通基盤技術開発/SiC次世代パワーエレクトロニクスの統合的研究開発」であり、再委託先の研究課題及び研究機関が決定されているため。	16,000,000	-
「次世代SiCデバイスの技術開発」のうち、「SiC高耐圧デバイス基礎設計、及びSiC酸化膜界面の基礎物性解明」に関する委託事業	理事長 中鉢 良治（東京都千代田区霞が関一丁目3番1号）	平成26年11月11日	国立大学法人筑波大学 茨城県つくば市天王台1-1-1	本事業は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構からの委託事業「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）/次世代パワーエレクトロニクス/SiCに関する拠点型共通基盤技術開発/SiC次世代パワーエレクトロニクスの統合的研究開発」であり、再委託先の研究課題及び研究機関が決定されているため。	4,899,000	-
「次世代SiCモジュールの技術開発」のうち、「抵抗体の導電機構解明、及びモジュール要素構造評価試験」に関する委託事業	理事長 中鉢 良治（東京都千代田区霞が関一丁目3番1号）	平成26年11月11日	国立大学法人東京大学 東京都文京区本郷七丁目3番1号	本事業は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構からの委託事業「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）/次世代パワーエレクトロニクス/SiCに関する拠点型共通基盤技術開発/SiC次世代パワーエレクトロニクスの統合的研究開発」であり、再委託先の研究課題及び研究機関が決定されているため。	6,625,000	-
「次世代SiCモジュールの技術開発」のうち、「誘電体の絶縁機構解明」に関する委託事業	理事長 中鉢 良治（東京都千代田区霞が関一丁目3番1号）	平成26年11月11日	国立大学法人東京工業大学 東京都目黒区大岡山二丁目12番1号	本事業は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構からの委託事業「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）/次世代パワーエレクトロニクス/SiCに関する拠点型共通基盤技術開発/SiC次世代パワーエレクトロニクスの統合的研究開発」であり、再委託先の研究課題及び研究機関が決定されているため。	2,980,000	-